(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-55559

(P2001-55559A)

(43)公開日 平成13年2月27日(2001.2.27)

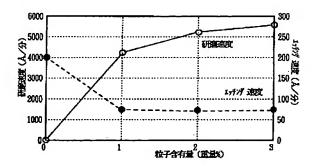
(51) Int.Cl. ⁷		設別記号	•	FI					テー	73~}*(参考	ş)
C09K	3/14	5 5 0		C 0	9 K	3/14		5500	С	4 J 1 O 0)
								5502	Z	5 F O 4 3	}
C08F	20/34			C 0	8F	20/34					
	20/42					20/42					
	20/52					20/52					
			審査請求	未請求		•	OL	(全 8]	頁)	最終頁に	:続く
(21)出願番		特顯平11-231668		(71)	出願人	000004	178				
						ジェイ	エスア	ール株式会	会社		
(22)出顧日		平成11年8月18日(1999			東京都	中央区	築地2丁目	111#	24号		
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 元成			正之					
						東京都	中央区	築地二丁E	311番	24号 ジ:	ェイ
								式会社内			
				(72)	発明者	服部	奉新				
						東京都	中央区	築地二丁目]11番	24号 ジ:	エイ
						エスア	ール株	式会社内			
				(74)	代理人	100094	190				
						弁理士	小島	清路			
										最終質に	続く
										最終	質に

(54) 【発明の名称】 化学機械研磨用水系分散体

(57)【要約】

【課題】 銅等の研磨において、被研磨面にスクラッチ 等を生ずることなく、且つ十分な速度で研磨することが できる化学機械研磨用水系分散体を提供する。

【解決手段】 陽イオンを形成し得る官能基を有する有機粒子と、水とを含有する水系分散体を得る。陽イオンを形成し得る官能基を有する有機粒子は、この特定の官能基を有するアゾ系の重合開始剤を使用し、メチルメタクリレート等を重合させることにより生成させることができる。また、ポリスチレン等の存在下、上記の重合開始剤を用いて、メチルメタクリレート等を重合させることにより生成させることもできる。更に、この有機粒子は、3-アミノー2-ヒドロキシブロビルメタクリレート等の特定の官能基を有する単量体を、メチルメタクリレート等の他の単量体と共重合させることにより生成させることもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機粒子及び水を含有し、該有機粒子 が、被研磨面を形成する金属と反応し得る官能基を有す ることを特徴とする化学機械研磨用水系分散体。

【請求項2】 有機粒子及び水を含有し、該有機粒子 が、陽イオンを形成し得る官能基を有することを特徴と する化学機械研磨用水系分散体。

【請求項3】 更に酸化剤を含有する請求項1又は2記 載の化学機械研磨用水系分散体。

【請求項4】 上記官能基が、アミノ基、ピリジル基及 10 びアクリルアミド基のうちの少なくとも1種である請求 項1乃至3のうちのいずれか1項に記載の化学機械研磨 用水系分散体。

【請求項5】 上記有機粒子は、その分子中に上記官能 基を導入し得る重合開始剤を用いて得られる重合体であ る請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の化学機 械研磨用水系分散体。

【請求項6】 上記有機粒子は、その分子中に上記官能 基を導入し得る単量体を用いて得られる重合体である請 求項1乃至5のうちのいずれか1項に記載の化学機械研 20 磨用水系分散体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の製造 において有用な化学機械研磨用水系分散体(以下、「水 系分散体」ということもある。) に関する。更に詳しく は、本発明は、被研磨面を形成する金属と反応し得る官 能基、特に、陽イオンを形成し得る官能基を有する有機 粒子を水に分散させてなり、半導体装置の被加工膜など の研磨に好適な水系分散体に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置の集積度の向上、多層配線化 などにともない、被加工膜等の研磨に化学機械研磨の技 術が導入されている。これはプロセスウェハ上の絶縁膜 に形成された孔、溝などに、タングステン、アルミニウ ム、銅等の配線材料を埋め込んだ後、研磨により余剰の 配線材料を除去することにより配線を形成するものであ る。この研磨技術においては、従来より、シリカ、或い は金属酸化物からなる研磨粒子を含む水系分散体が研磨 硬度が高く、被研磨面に、LSIの信頼性を低下させる スクラッチ及びディッシング等が発生するという問題が ある。特に、現在、その使用が検討されている硬度の低 い多孔質の絶縁膜においては、スクラッチ等の抑制がよ り大きな検討課題となる。

【0003】 このスクラッチ等の発生を抑えるため、研 磨粒子として重合体粒子を用いることが提案されてい る。特開平10-270400号公報には、乳化重合に より得られるビニル化合物重合体粒子を含有する水性エ

ている。また、この乳化重合の重合開始剤として2、2 -アゾビス(2-アミノプロパン)塩酸塩が例示されて いる。しかし、この化合物は単に重合開始剤の一例とし て記載されているにすぎず、他の何らかの作用を有する か否か等についてはまったく言及されていない。更に、 特開平10-168431号公報には、高分子電解質を コーティングした研磨剤粒子を含有する研磨用スラリが 開示されている。しかし、との研磨剤粒子は無機粒子で ある。しかも、その全面に高分子電解質がコーティング された場合は、研磨速度が低下することも示唆されてい る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、特定の官能 基を有する有機粒子を含有する化学機械研磨用水系分散 体を提供することを課題とする。また、特に、本発明 は、銅等の硬度の低い金属面であっても、被研磨面にお いてスクラッチ等を生ずることなく、且つ適度なエッチ ング速度と、十分な研磨速度とを併せ有し、半導体装置 の被加工膜等の研磨において有用な水系分散体を提供す ることを課題とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題は、第1に被研 磨面を形成する金属と反応し得る官能基を有する有機粒 子を含有する化学機械研磨用水系分散体(以下、第1発 明という。) により達成される。上記課題は、第2に陽 イオンを形成し得る官能基を有する有機粒子を含有する 化学機械研磨用水系分散体(以下、第2発明という。) により達成される。また、上記課題は、第3に更に酸化 剤を含有させることにより達成される。上記課題は、第 30 4に上記官能基を特定すること(以下、第4発明とい う。) により達成される。更に、上記課題は、第5に特 定の重合開始剤を用いて合成した重合体を用いること (以下、第5発明という。) により達成される。上記課 題は、第6 に特定の単量体を用いて合成した重合体を用 いること(以下、第6発明という。)により達成され

【0006】第1発明の化学機械研磨用水系分散体は、 有機粒子及び水を含有し、該有機粒子が、被研磨面を形 成する金属と反応し得る官能基を有することを特徴とす 剤として用いられている。しかし、これらの研磨粒子は(40)る。ここでいう反応とは、共有結合、イオン結合、配位 結合等の化学結合の形成を意味する。また、第2発明の 化学機械研磨用水系分散体は、有機粒子及び水を含有 し、該有機粒子が、陽イオンを形成し得る官能基を有す ることを特徴とする。

【0007】第1及び第2発明における有機粒子の平均 粒子径は $0.01\sim10\mu$ mであることが好ましく、特 $k0.01\sim5\mu m$ 、更には $0.01\sim3\mu m$ であるこ とがより好ましい。有機粒子の平均粒子径が0.01 μ m未満であると、研磨速度が低下し、この平均粒子径が マルジョンからなる半導体装置製造用研磨剤が記載され 50 10μmを超える場合は、有機粒子が沈降し易く、安定 な水系分散体とすることが容易ではない。これらの平均 粒子径は、透過型電子顕微鏡によって観察することによ り測定することができる。

【0008】第3発明は、第1乃至第2発明において、 更に酸化剤を含有させることができる旨を明らかにした ものである。酸化剤としては、過硫酸カリウム、過硫酸 アンモニウム、過酸化水素、硝酸及び硫酸等を使用する ことができ、過硫酸カリウムが特に好ましい。この酸化 剤の含有量は0.01~5重量部(以下、「部」と略記 する。)とすることができ、0.1~4部、特に0.3 10 用する必要はない。 ~3部とすることが好ましい。

【0009】第4発明は、第1乃至第3発明において、 有機粒子が有する官能基、特に、陽イオンを形成し得る 官能基のうち、推奨される官能基を明らかにしたもので ある。との官能基としては、アミノ基、ピリジル基及び アクリルアミド基が挙げられる。これらのうちでもアミ ノ基が特に好ましい。尚、この官能基は、第2発明に例 示した以外のカチオン基とすることもできる。

【0010】第5発明は、第1乃至第4発明において、 有機粒子は、特定の重合開始剤を使用することにより、 分子中に、特定の官能基が導入された重合体である旨を 明らかにしたものである。

【0011】 ここで、重合体を合成する際に使用し得る 単量体としては、スチレン、α-メチルスチレン等のビ ニル芳香族化合物、アクリル酸、メタクリル酸等の不飽 和カルボン酸化合物、無水マレイン酸等の不飽和ジカル ボン酸の無水物等が挙げられる。更に、メチルアクリレ ート、エチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリ レート等のアクリル酸エステル、メチルメタクリレー リレート等のメタクリル酸エステルを挙げることもでき る。とれらの単量体は、1種のみを用いてもよいし、2 種以上を併用してもよい。

【0012】分子中に特定の官能基を導入することがで きる重合開始剤としては、2,2'-アゾビス-(2-アミジノプロパン)二塩酸塩(例えば、商品名「V-5 二塩酸塩、アゾビスイソブチロニトリル(例えば、商品 名「V-60」)、1、1'-アゾビス-(シクロヘキ サン-1-カルボニトリル) (例えば、商品名「V-4 0」)、2,2'-アゾビス-(2,4-ジメチルバレ ロニトリル)、2,2'-アゾビス-(4-メトキシー 2. 4-ジメチルバレロニトリル) (例えば、商品名 「V-70」)等が挙げられる。以上、商品名を挙げた 重合開始剤はいずれも和光純薬工業株式会社製である。 【0013】 ことで、上記特定の重合開始剤を使用した 重合体の合成は、コア粒子として他の重合体粒子が存在 する状態で実施することもできる。この重合体粒子とし ては、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等、上

挙げることができる。

【0014】とれら特定の重合開始剤の使用量は、重合 体を合成する際に使用する単量体と、場合により用いら れるコア粒子としての重合体粒子との合計量100部に 対して、0.1~7部とすることができ、0.5~4 部、特に0.5~3部とすることが好ましい。上記特定 の重合開始剤の使用量が0.1部未満であると、研磨速 度が十分に向上せず、一方、この重合開始剤を7部使用 すれば所期の効果が十分に得られ、それ以上に多量に使

【0015】第5発明における重合体は、溶液重合、乳 化重合、懸濁重合等、各種の一般的な方法によって製造 することができる。重合温度、重合時間、その他の重合 条件は、使用する単量体の種類、及び所要の分子量等の 特性に応じて適宜設定することができる。

【0016】第6発明は、有機粒子は、特定の単量体を 重合成分、或いは共重合成分として使用することによ り、分子中に、特定の官能基が導入された重合体である 旨を明らかにしたものである。上記特定の単量体として 20 は、以下の各種のものが挙げられる。

(1) 3-アミノ-2-ヒドロキシプロピル (メタ) ア クリレート等の置換ヒドロキシアルキル (メタ) アクリ レート類、(2)2-ジメチルアミノエチル(メタ)ア クリレート、2 -ジエチルアミノエチル (メタ) アクリ レート、2-ジメチルアミノプロピル (メタ) アクリレ ート、3-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリレー ト等のアミノアルキル基含有(メタ)アクリレート類、 【0017】(3)2-(ジメチルアミノエトキシ)エ チル (メタ) アクリレート、2 - (ジエチルアミノエト ト、エチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタク 30 キシ) エチル (メタ) アクリレート、3- (ジメチルア ミノエトキシ) プロビル (メタ) アクリレート等のアミ ノアルコキシアルキル基含有(メタ)アクリレート類、 (4) 2-(2'-ヒドロキシ-5'-メタクリロキシ エチルフェニル) -2H-ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-メタクリロキシエチル-3'-t-ブチルフェニル)-2H-ベンゾトリアゾー ル等の紫外線吸収性官能基含有(メタ)アクリレート 類、(5)1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピ ペリジル (メタ) アクリレート、2, 2, 6, 6ーテト ラメチルー4ーピペリジル(メタ)アクリレート等の光 安定化基含有(メタ)アクリレート類、

【0018】(6) N-メチル(メタ) アクリルアミ ド、N-エチル (メタ) アクリルアミド、N-メチルー N-エチル (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル (メタ) アクリルアミド、N, N-ジエチル (メタ) ア クリルアミド等のN-アルキル基含有(メタ)アクリル アミド類、(7) N-(2-ジメチルアミノエチル(メ タ) アクリルアミド、N-(2-ジエチルアミノエチル (メタ) アクリルアミド、N-(2-ジメチルアミノブ 記各種の単量体を重合、或いは共重合させてなる粒子を 50 ロビル(メタ)アクリルアミド、N-(3-ジメチルア

ミノプロピル (メタ) アクリルアミド等のN-アミノア ルキル基含有(メタ)アクリルアミド類

【0019】(8) 2-ビニルピリジン、4-ビニルピ リジン等のビニルピリジン類、(9)(メタ)アクリル アミド、N-メトキシメチル (メタ) アクリルアミド、 N-プトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N. N-ジメトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N, N'-メチレンビス (メタ) アクリルアミド、N, N'-エチ レンビス (メタ) アクリルアミド、マレイン酸アミド、 マレイミド等の不飽和カルボン酸のアミド、或いはイミ ド、(10)(メタ)アクリロニトリル、クロトンニト リル、ケイ皮酸ニトリル等の不飽和カルボン酸ニトリル 類、(11)N-メチロール(メタ)アクリルアミド、 N, N-ジメチロール (メタ) アクリルアミド等のN-メチロール化不飽和カルボン酸アミド類。

【0020】上記特定の単量体は、1種のみを用いても よいし、2種以上を併用することもできる。また、上記 特定の単量体と、前述した第5発明における重合体を合 成する際に使用する単量体を併用して共重合体とすると ともできる。この第6発明において、重合開始剤として 20 は、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル及び過酸化水素等を使用す ることができる。更に、第5発明における特定の重合開 始剤を使用することもできる。また、重合開始剤の使用 量は、重合体を合成する際に使用する単量体100部に 対して、0.1~5部とすることができ、0.5~4 部、特に1~3部とすることが好ましい。

【0021】ととで、上記特定の単量体を使用した重合 体の合成は、コア粒子として他の重合体粒子が存在する 状態で実施することもできる。この重合体粒子として は、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等、第5 発明と同様の各種の単量体を重合、或いは共重合させて なる粒子を挙げることができる。特定の単量体の使用量 は、重合体を合成する際に使用する単量体と、場合によ り用いられるコア粒子としての重合体粒子との合計量1 00部に対して、0.1~5部とすることができ、0. 5~4部、特に1~3部とすることが好ましい。特定の 単量体の使用量が0.1部未満であると、研磨速度が十 分に向上しない。一方、この単量体を5部使用すれば所 期の効果が十分に得られ、それ以上に多量に使用する必 40 要はない。

【0022】第6発明における重合体は、溶液重合、乳 化重合、懸濁重合等、各種の一般的な方法によって製造 することができる。重合温度、重合時間、その他の重合 条件は、使用する単量体の種類、及び所要の分子量等の 特性に応じて適宜設定することができる。

【0023】本発明における有機粒子の調製方法は特に 限定されないが、水系媒体、又は有機溶媒を用いて重合 体を製造した後、得られる重合体を粉砕し、所定の粒径 単量体を水系媒体等に微分散させ、所定の粒径を有する 有機粒子とする方法などを挙げることもできる。

【0024】化学機械研磨用水系分散体の調製方法とし ては、水系媒体を用いて所定の粒径を有する有機粒子を 生成させ、この水系分散体をそのまま用いる方法が最も 簡便である。また、生成した有機粒子を水系媒体から分 離した後、再び媒体に分散させることもできる。この方 法であれば、有機粒子の含有量を容易に調整することが できる。更に、重合体を有機溶媒を用いて製造した場合 10 であっても、得られる重合体が粒子状であれば、有機溶 媒を蒸留等によって除去し、水或いは水系媒体と置換す ることにより容易に水系分散体とすることができる。水 系媒体としては、水及び水とメタノール等との混合物が 挙げられるが、水のみを用いることが好ましい。

【0025】化学機械研磨用水系分散体に含有される有 機粒子は、水系分散体を100部とした場合に、0.1 ~20部、特に0.5~15部、更には1~10部であ ることが好ましい。また、研磨粒子として機能する有機 粒子の形状は球状であることが好ましいが、この球状と は、鋭角部分を有さない略球形のものをも意味し、必ず しも真球に近いものである必要はない。球状の有機粒子 を用いることにより、被研磨面におけるスクラッチの発 生がより確実に抑えられ、且つ十分な速度で研磨すると とができる。

【0026】第1乃至第6発明の水系分散体では、無機 粒子の配合は必要ないが、スクラッチ等の発生が十分に 抑えられる範囲で、シリカ、並びにアルミナ、チタニ ア、ジルコニア、セリア、酸化鉄及び酸化マンガン等の 金属酸化物などからなる無機粒子を含有させることもで 30 きる。尚、との金属酸化物が酸化鉄、酸化マンガン等の 酸化力を有するものである場合は、酸化剤としても機能 する。そのため、前記の酸化剤の使用量を低減すること ができ、酸化剤の使用が必要ないこともある。

【0027】本発明の化学機械研磨用水系分散体は、超 LSI等の半導体装置の製造過程において、半導体基板 上に設けられる各種の被加工膜、及びタンタル、チタン 等の金属、或いはそれらの酸化物、窒化物などからなる バリアメタル層の研磨に用いることができる。被加工膜 としては、シリコン酸化膜、アモルファスシリコン膜、 多結晶シリコン膜、単結晶シリコン膜、シリコン窒化 膜、純タングステン膜、純アルミニウム膜、或いは純銅 膜等の他、タングステン、アルミニウム、銅等と他の金 属との合金からなる膜などが挙げられる。また、本発明 の水系分散体は、これらの各種の被加工膜のうちでも、 純銅膜等の硬度の低いものの研磨において特に有用であ る。

【0028】半導体装置の被加工膜の研磨は、無機粒子 を研磨粒子とする従来の方法において用いられている市 販の化学機械研磨装置(ラップマスターSFT社製、型 に整粒する方法が挙げられる。更に、重合体の製造時に 50 式「LGP510、LGP552」等)を用いて行なう

ことができる。 尚、研磨後、被研磨面に残留する有機粒 子は除去することが好ましい。この粒子の除去は通常の 洗浄方法によって行うことができるが、有機粒子の場合 は、被研磨面を、酸素の存在下、髙温にすることにより 粒子を燃焼させて除去することもできる。燃焼の方法と しては、酸素プラズマに晒したり、酸素ラジカルをダウ ンフローで供給すること等のプラズマによる灰化処理等 が挙げられ、これによって残留する有機粒子を被研磨面 から容易に除去することができる。

【0029】本発明の水系分散体には、有機粒子の他、 酸化剤等、必要に応じて各種の添加剤を配合することが できる。それによって分散状態の安定性を更に向上させ たり、研磨速度を髙めたり、2種以上の被加工膜等、硬 度の異なる被研磨膜の研磨に用いた場合の研磨速度の差 異を調整したりすることができる。具体的には、アルカ リ金属の水酸化物或いはアンモニア、無機酸若しくは有 機酸を配合し、pHを調整することによって水系分散体 の分散性及び安定性を向上させることができる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、実施例によって本発明を詳 20 しく説明する。

(1) 重合体粒子の合成

合成例1

メチルメタクリレート100部、ラウリルトリメチルア ンモニウムクロライド 0. 1部、重合開始剤(和光純薬 工業株式会社製、商品名「V-50」)2部、及びイオ ン交換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入 し、窒素ガス雰囲気下、撹拌しながら70℃に昇温し、 6時間重合させ、分子鎖の末端にアミノ基が導入された 機粒子の平均粒子径は0.24μmであった。また、ポ リメチルメタクリレートの重合収率は97%であった。 【0031】合成例2

平均粒子径200nmのポリスチレン50部、メチルメ タクリレート50部、ラウリルトリメチルアンモニウム クロライド0.1部、「V-50」2部、及びイオン交 換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入し、 窒素ガス雰囲気下、攪拌しながら70°Cに昇温し、6時 間重合させ、ポリスチレン粒子の表面に、分子鎖の末端 にアミノ基が導入されたポリメチルメタクリレートが付 着し、複合された重合体からなる有機粒子を得た。有機 粒子の平均粒子径は0.27μmであった。また、ポリ メチルメタクリレートの重合収率は97%であった。

【0032】合成例3

平均粒子径200nmのポリスチレン90部、メチルメ タクリレート8部、3-アミノ-2-ヒドロキシプロピ ルメタアクリレート2部、ラウリルトリメチルアンモニ ウムクロライド0.2部、クメンヒドロパーオキサイド 0. 2部、アスコルビン酸カリウム0. 1部、及びイオ ン交換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入 50 チング速度を評価した。

し、窒素ガス雰囲気下、撹拌しながら70℃に昇温し、 6時間重合させ、ポリスチレン粒子の表面に、分子鎖に アミノ基を有するメタクリレート系共重合体が付着し、 複合された重合体からなる有機粒子を得た。有機粒子の 平均粒子径は0.25μmであった。また、メタクリレ ート系共重合体の重合収率は98%であった。

【0033】合成例4

メチルメタクリレート97部、3-アミノー2-ヒドロ キシプロピルメタクリレート3部、ラウリルトリメチル 10 アンモニウムクロライド 0.15部、クメンヒドロパー オキサイド0.2部、アスコルビン酸カリウム0.1 部、及びイオン交換水400部を、容量2リットルのフ ラスコに投入し、窒素ガス雰囲気下、攪拌しながら70 ℃に昇温し、6時間重合させ、分子鎖にアミノ基を有す るメタクリレート系共重合体からなる有機粒子を得た。 有機粒子の平均粒子径は0.23μmであった。また、 メタクリレート系共重合体の重合収率は97%であっ た。

【0034】比較合成例1

重合開始剤を「V‐50」から過硫酸アンモニウムに代 え、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドをラウ リル硫酸アンモニウムに代えた他は、合成例1と同様に して有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0.25 μmであった。また、ポリメチルメタクリレートの重合 収率は98%であった。

【0035】比較合成例2

重合開始剤を「V-50」から過硫酸アンモニウムに代 え、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドをラウ リル硫酸アンモニウムに代えた他は、合成例2と同様に ボリメチルメタクリレートからなる有機粒子を得た。有 30 して有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0.24 μmであった。また、ポリメチルメタクリレートの重合 収率は97%であった。

比較合成例3

3-アミノ-2-ヒドロキシプロピルメタアリクリレー トに代えてアクリル酸を用い、ラウリルトリメチルアン モニウムクロライドに代えてラウリル硫酸アンモニウム を用いた他は、合成例3と同様にして有機粒子を得た。 有機粒子の平均粒子径は0.23μmであった。また、 メチルメタクリレートーアクリル酸共重合体の重合収率 40 は97%であった。

【0036】実施例1(合成例1の有機粒子を含有する 水系分散体の調製及びそれを用いた研磨試験)

イオン交換水に、合成例1の有機粒子を2.0重量% (以下、「%」と略記する。) の濃度になるように配合 し、これに更に過硫酸カリウムを0.5%の濃度になる ように添加し、水酸化カリウムによってpHを8.2に 調整し、化学機械研磨用水系分散体を調製した。との水 系分散体を使用して銅膜付きウェハ (膜厚:15000 A) を研磨し、スクラッチの有無、研磨速度、及びエッ

【0037】のスクラッチの有無

被研磨面を洗浄し、乾燥した後、微分干渉顕微鏡により スクラッチの有無を確認した。評価結果を表1に示す。 【0038】②研磨速度

小型の化学機械研磨装置(ラップマスターSFT社製、 型式「LM-15」)を用い、下記の条件で研磨し、下 記の式によって研磨速度を算出した。評価結果を表1に 示す。テーブル回転数及びヘッド回転数: 45 r p m、 研磨圧力;233g/cm'、オッシレーションストロ ーク;5回/分、研磨剤供給速度;50cc/分、研磨 10 時間:3分、研磨パッド:多孔質ポリウレタン製(ロデ ール・ニッタ社製、品番「IC1000」/「SUBA 400」の2層構造)

研磨速度(A/分)=(研磨前の銅膜の厚さ-研磨後の 銅膜の厚さ)/研磨時間

【0039】3エッチング速度

2×2cmに割り取った銅膜付きウェハを水系分散体に 30分間浸漬し、浸漬前後の銅膜の厚さを測定し、下記 の式によってエッチング速度を算出した。評価結果を表 1 に示す。

エッチング速度(A/分)=(浸漬前の銅膜の厚さ-浸 漬後の銅膜の厚さ) /浸漬時間

【0040】実施例2-②及び実施例2-②(合成例1 の有機粒子の含有量の異なる水系分散体の調製及びそれ を用いた研磨試験)

有機粒子を、1.0% (実施例2-Φ)、及び3.0% (実施例2-②)の濃度になるように配合した他は実施 例1と同様にして化学機械研磨用水系分散体を調製し た。これらの水系分散体を使用し、実施例1と同様にし て銅膜付きウェハ(膜厚:15000人)を研磨し、実 30 体を調製した。 施例1と同様にして、スクラッチの有無、研磨速度、及 びエッチング速度を評価した。上記実施例1並びにこれ ら実施例2-●及び実施例2-②の水系分散体の研磨速 度及びエッチング速度の評価結果を表1及び図1に示

【0041】以上の評価の結果、有機粒子の濃度に関わ りなく、実施例1並びに実施例2-①及び実施例2-② のいずれの水系分散体においてもスクラッチはまったく 観察されなかった。また、図1の結果によれば、有機粒 子を1%含有させることによって研磨速度が非常に大き くなり、その後も含有量の増加とともに研磨速度が大き くなる傾向にあることが分かる。また、有機粒子を1% 含有させることにより、含有しない場合に比べてエッチ ング速度が大きく低下し、75 A/分の適度なエッチン グ速度となり、有機粒子の含有量を増加させても、同程 度のエッチング速度が維持されることが分かる。

【0042】実施例3~5(合成例2~4の有機粒子を 含有する水系分散体の調製及びそれらを用いた研磨試

子、及び過硫酸カリウムを、それぞれ2部及び0、5部 の濃度になるように配合し、水酸化カリウムによりpH を調整し、水系分散体を調製した。これらの水系分散体 を使用し、実施例1と同様にしてスクラッチの有無、及 びエッチング速度を評価した。評価結果を表1に示す。 【0043】また、化学機械研磨装置(ラップマスター SFT社製、型式「LGP-510」)を用い、下記の 条件で銅膜付きウェハを研磨し、前記の式によって研磨 速度を算出した。評価結果を表1に示す。テーブル回転 数及びヘッド回転数;50rpm、研磨圧力;300g /cm²、研磨剤供給速度;100cc/分、研磨時 間;1分、研磨パッド;多孔質ポリウレタン製(ロデー ル・ニッタ社製、品番「IC1000」/「SUBA4 00」の2層構造)

【0044】比較例1~3(比較合成例1~3の有機粒 子を含有する水系分散体の調製及びそれらを用いた研磨 試験)

比較合成例1~3において得られた有機粒子を使用し、 有機粒子及び過硫酸カリウムを、それぞれ2部及び0. 20 5部の濃度になるように配合し、水酸化カリウムでpH を調整することで水系分散体を調製した。これらの水系 分散体を使用し、実施例1と同様にしてスクラッチの有 無、研磨速度、及びエッチング速度を評価した。評価結 果を表1に示す。

【0045】比較例4~5(比較例4~5の水系分散体 の調製及びそれらを用いた研磨試験)

比較例4

イオン交換水に0.5部の過硫酸カリウムを含有させ、 水酸化カリウムによりpHを8、3に調製して水系分散

【0046】比較例5

ヒュームド法シリカ粒子(日本アエロジル株式会社製、 商品名「アエロジル#50」)50gを容量2リットル のポリエチレン製の瓶に入れ、イオン交換水500gを 加え、超音波分散機によって分散させてヒュームド法シ リカ粒子を含有する水分散体を調製した。その後、3% 濃度の過硫酸カリウム水溶液167gを添加し、十分に 攪拌した。次いで、水酸化カリウム水溶液によりpHを 8. 0に調整し、更にイオン交換水を投入して全量を1 40 kgとした。その後、十分に攪拌し、孔径5μmのフィ ルタで濾過して化学機械研磨用水系分散体を得た。これ らの水系分散体を使用し、実施例1と同様にしてスクラ ッチの有無、研磨速度、及びエッチング速度を評価し た。評価結果を表1に示す。

【0047】尚、以上の実施例及び比較例において、銅 膜の厚さは抵抗率測定機(NPS社製、型式「Σー 5」) により直流4探針法でシート抵抗を測定し、この シート抵抗値と銅の抵抗率から下記の式によって算出し

イオン交換水に、合成例2~4 において得られた有機粒 50 銅膜の厚さ(Å)= [シート抵抗値(Ω / c m $^{\prime}$)×銅

12

の抵抗率 (Q/cm)]×10° [0048]

*【表1】

* 表 1

		スクラッチの 有 無	研磨速度(Å/分)	1, f ング 速 度 (Å / 分)	рΗ
	1		5 3 0 0	7 5	8.2
	2 - ①		4200	7 5	8.2
== +\- Fd	2 - ②	なし	5700	7 5	8.2
実施例	3		4 4 0 0	5 5	7.5
	4		4600	5 0	7.7
	5		5 1 5 0	5 5	8.0
	1	なし	150	4 5	8.1
	2		170	4 2	7.5
比較例	3		2 1 0	5 0	8.0
	4	若 干あり	3 0	2 3 0	8.3
	5	あり	750	1 3 5	8.1

【0049】表1の結果によれば、実施例1~5の水系 分散体では、スクラッチはまったくみられず、研磨速度 とエッチング速度とのバランスに優れていることが分か る。一方、比較例1~3の水系分散体では、スクラッチ は問題ないものの、研磨速度が非常に小さい。また、比 較例4の水系分散体では、スクラッチが若干みられ、研 30 い。 磨速度が極めて小さく、エッチング速度は極めて大き い。更に、比較例5の水系分散体では、スクラッチがみ られ、研磨速度は小さく、エッチング速度は相当に大き いことが分かる。 Ж

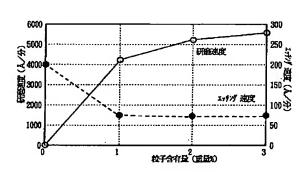
%[0050]

【発明の効果】第1乃至第6発明の化学機械研磨用水系 分散体によれば、特に、銅膜等の半導体装置の被加工膜 などの研磨において、十分な速度で研磨することができ るとともに、被研磨面にスクラッチを生ずることがな

【図面の簡単な説明】

【図1】合成例1の有機粒子を含有する水系分散体によ り銅膜を研磨した場合の、有機粒子の含有量と、研磨速 度及びエッチング速度との相関を示すグラフである。

【図1】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

622

21/306

FΙ

テーマコード(参考)

HO1L 21/304

622D

21/306

M

(72)発明者 川橋 信夫

HO1L 21/304

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J100 AB02P AB03P AJ02P AJ09P

ALO3P ALO4P ALO8P AMO1P

AMO2P AM15P AM17P AM19P

AM21P AM24P AM33P AM43P

AQ12P BA02P BA03P BA05P BA29P BA31P BC43P BC65P

BC73P CA01 EA07 FA03

JA28

5F043 AA26 BB18 BB30 DD16 DD30

GG10

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-055559

(43) Date of publication of application: 27.02.2001

(51)Int.CI.

C09K 3/14 COSF 20/34 C08F 20/42 C08F 20/52 H01L 21/304 H01L 21/306

(21)Application number: 11-231668

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

18.08.1999

(72)Inventor: MOTONARI MASAYUKI

HATTORI MASAYUKI KAWAHASHI NOBUO

(54) AQUEOUS DISPERSION FOR CHEMICAL AND MECHANICAL POLISHING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aqueous dispersion for chemical and mechanical polishing which can effect polishing without causing scratches and like on the surface to be polished with a sufficient speed in polishing copper and the like. SOLUTION: An aqueous dispersion containing organic particles having a functional group capable of forming a cation and water is obtained. The organic particles having a functional group capable

of forming a cation can be formed by polymerizing methyl methacrylate and the like with the use of an azo type polymerization initiator having the functional group. Further, they can also be formed by polymerizing methyl methacrylate and the like in the presence of a polystyrene and the like with the use of the polymerization initiator. In addition, these organic particles can be formed by copolymerizing a monomer having a specific functional

§ 1000

group such as 3-amino-2-hydroxypropyl methacrylate with another monomer such as methyl methacrylate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office